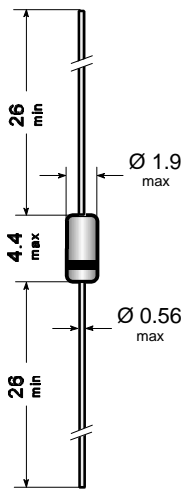


Small Signal Si-Diodes
Si-Allzweck-Dioden


Dimensions / Maße in mm

| | |
|--|-------------------------------|
| Nominal current Nennstrom | 150 mA |
| Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung | 50...100 V |
| Glass case Glasgehäuse | DO-35 SOD-27 |
| Weight approx. Gewicht ca. | 0.13 g |
| Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack | see page 17 siehe Seite 17 |

Maximum ratings
Grenzwerte

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] |
|-------------|--|---|
| 1N 4148 | 75 | 100 |
| 1N 4150 | 50 | 50 |
| 1N 4151 | 50 | 75 |
| 1N 4448 | 75 | 100 |

| | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | I_{FAV} | 150 mA ¹⁾ |
| Max. power dissipation Verlustleistung | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | P_{tot} | 500 mW ¹⁾ |
| Peak forward surge current, single half sine-wave, superimposed on rated load Stoßstrom für eine 50Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | I_{FSM} | 500 mA |
| Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur | | T_j T_s | – 50...+200°C – 50...+200°C |

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics, $T_i = 25^\circ\text{C}$ **Kennwerte, $T_i = 25^\circ\text{C}$**

| Type | Forward voltage | | Leakage current | | Reverse recovery time *) |
|---------|------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| Typ | Durchlaßspannung | | Sperrstrom | | Sperrverzugszeit *) |
| | V_F [V] | at I_F [mA] | I_R [nA] | at V_R [V] | t_{rr} [ns] |
| 1N 4148 | < 1 | 10 | < 25 | 20 | < 4 |
| 1N 4150 | < 1 | 200 | <100 | 50 | < 4 |
| 1N 4151 | < 1 | 50 | < 50 | 50 | < 2 |
| 1N 4448 | < 1 | 100 | < 25 | 20 | < 4 |

*) $I_F = 10$ mA through / über $I_R = 10$ mA to / bis $I_R = 1$ mA, $U_R = 6$ V, $R_L = 100\Omega$

Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

$R_{thA} < 0.3$ K/mW¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden